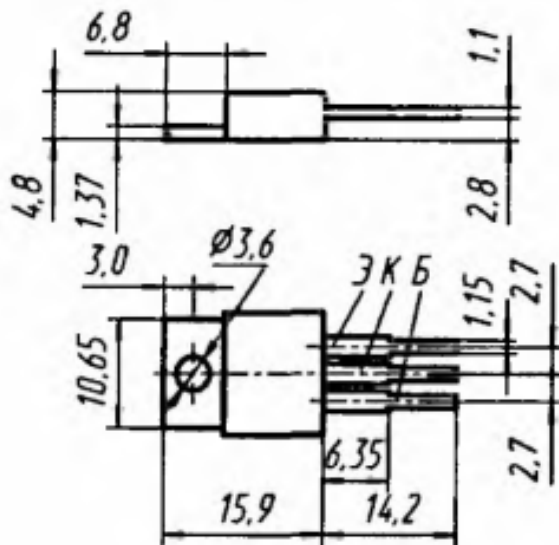


## КТ863А, КТ863Б, КТ863В

КТ863(А-В)



Транзисторы кремниевые мезазпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* усильтельные. Предназначены для применения в преобразователях напряжения, источниках вторичного электропитания, электронных фотовспышках. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 2,5 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.

### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{КБ} = 2$  В,  $I_3 = 5$  А, не менее:

КТ863А .....	100
КТ863Б, КТ863В .....	70

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{КБ} = 5$  В,  $I_3 = 0,5$  А, не менее .....

4 МГц  
20\* МГц

типичное значение .....

Граничное напряжение при  $I_3 = 30$  мА, не менее .....

30 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при  $I_к = 5$  А,  $I_б = 0,5$  А:

КТ863А, не более .....	0,3 В
типичное значение .....	0,25* В
КТ863Б, КТ863В, не более .....	0,5 В

Напряжение насыщения база—эмиттер

при  $I_к = 5$  А,  $I_б = 0,5$  А, не более .....

1,2 В  
1\* В

типичное значение .....

Обратный ток коллектора при  $U_{КБ} = 30$  В, не более:

$T = -40...+25$ °С .....	1 мА
$T = +100$ °С .....	3 мА

Обратный ток эмиттера при  $U_{ЭБ} = 5$  В, не более .....

3 мА

## Предельные эксплуатационные данные

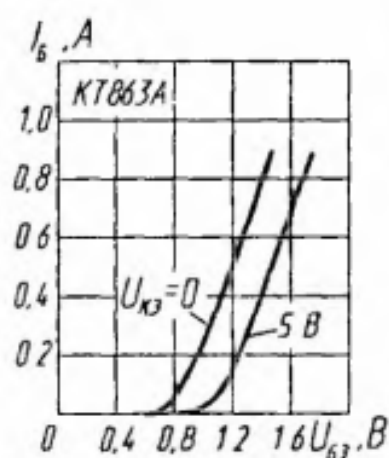
Постоянное напряжение коллектор—база:	
КТ863А, КТ863Б .....	30 В
КТ863В .....	160 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} = 10 \text{ Ом}$ .....	
	30 В
Постоянное напряжение база—эмиттер .....	
	5 В
Постоянный ток коллектора .....	
	10 А
Постоянный ток базы .....	
	3 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>1</sup> при $T_K = -40...+25 \text{ }^\circ\text{C}$ :	
с теплоотводом .....	50 Вт
без теплоотвода .....	1,5 Вт
Температура р-л перехода .....	
	+150 °С
Температура окружающей среды .....	
	-40... $T_K =$ = +100 °С

<sup>1</sup> При  $T_K = +25...+100 \text{ }^\circ\text{C}$  максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора снижается линейно до 20 Вт с теплоотводом и до 0,6 Вт без теплоотвода.

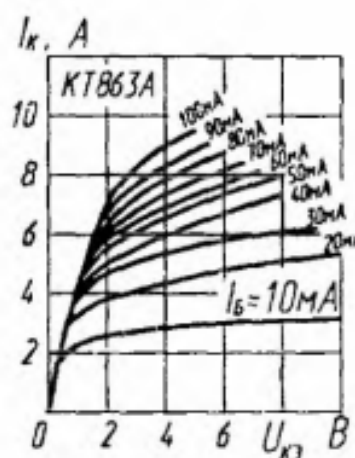
Допускается одноразовый изгиб выводов транзисторов не ближе 2,5 мм от корпуса под углом 90° с радиусом закругления не менее 0,8 мм.

Пайка выводов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса транзистора при температуре припоя +260 °С в течение не более 5 с. Допускается пайка волной припоя при температуре +235 °С. При пайке корпус паяльника должен быть заземлен.

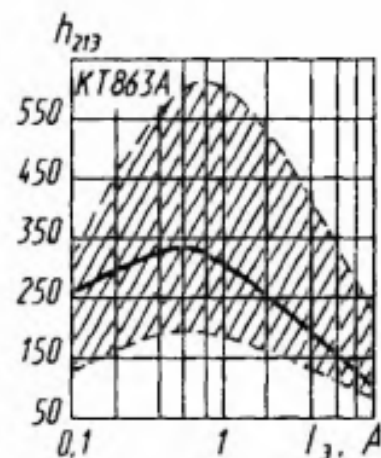
Допустимое значение статического потенциала 1000 В.



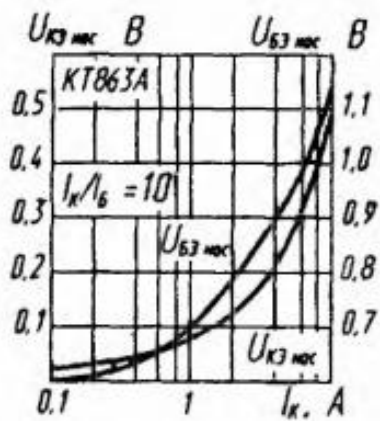
Входные характеристики



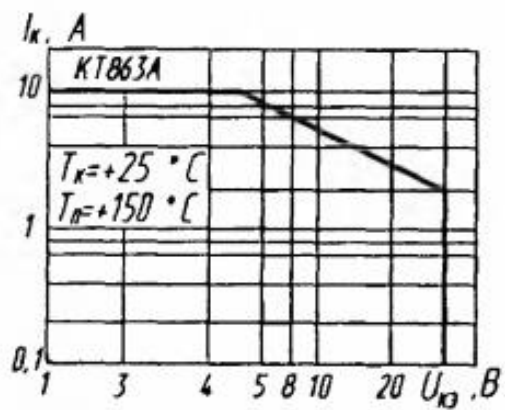
Выходные характеристики



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимости напряжений насыщения коллектор—эмиттер и база—эмиттер от тока коллектора



Область максимальных режимов